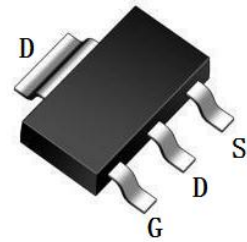


## LYNM110S5P (进口芯片) 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

### 特性

- 参照执行标准: QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式: SOT-223
- 开关速度快, 输入阻抗高, 驱动功耗小, 安全工作区宽, 温度稳定性好



SOT-223

### 极限参数

- 贮存温度  $T_{stg}$ :  $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度  $T_{amb}$ :  $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过  $260^{\circ}\text{C}$ , 焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 $P_D$ (W)	漏源电压 $BV_{DSS}$ (V)	栅源电压 $V_{GS}$ (V)	漏极电流 $I_D$ (A)	导通电阻 $R_{DS}$ ( $\Omega$ )	热阻 $R_{th(j-A)}$ ( $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ )
LYNM110S5P	2.0 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )	100	$\pm 20$	1.5 ( $T_C=25^{\circ}\text{C}$ )	0.54	60

### 主要电特性 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	100	—	—	V
零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=100\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	—	—	25	$\mu\text{A}$
		$V_{DS}=80\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, T_J=125^{\circ}\text{C}$	—	—	250	$\mu\text{A}$
正向栅极漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=20\text{V}$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=-20\text{V}$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	—	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=0.90\text{A}$	—	—	0.54	$\Omega$
跨导	$g_{FS}$	$V_{DS}=50\text{V}, I_D=0.90\text{A}$	1.1	—	—	S
电容	$C_{ISS}$	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	180	—	pF
	$C_{OSS}$	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	—	81	—	pF

SOT-223 封装尺寸图:

